

МЛЭ выращенные однослойные и многослойные структуры GaN, AlN, Al_xGa_{1-x}N на подложках:

Si(111),

GaN-Template/Si(111),

Сапфир Al₂O₃ (0001),

Template/Al₂O₃ (0001),

6H-SiC,

AlN c-plane

Применение: для создания транзисторных HEMT структур, туннельно-резонансных диодов и акустоэлектрических устройств и других электронных устройств на квантовых эффектах.